

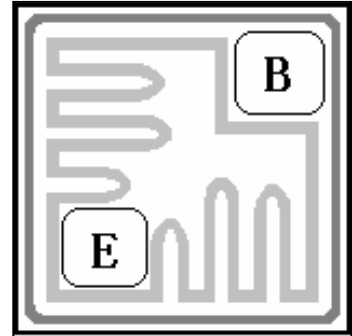


# 9013 晶体管芯片说明书

## 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)  
 芯片代码：C047BJ-00  
 芯片厚度：240±20μm  
 管芯尺寸：470×470μm<sup>2</sup>  
 焊位尺寸：B 极 103×103μm<sup>2</sup>，E 极 98×98μm<sup>2</sup>  
 电极金属：铝  
 背面金属：金  
 典型封装：SS9013，H9013，8050S

## 管芯示意图



## 极限值 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-92)

T<sub>stg</sub>——贮存温度..... -55~150  
 T<sub>j</sub>——结温.....150  
 P<sub>C</sub>——集电极耗散功率.....625mW  
 V<sub>CBO</sub>——集电极—基极电压.....40V  
 V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压.....20V  
 V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压.....5V  
 I<sub>C</sub>——集电极电流.....700mA

## 电参数 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I <sub>CBO</sub>	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V <sub>CB</sub> =25V，I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V <sub>EB</sub> =3V，I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直流电流增益	80		390		V <sub>CE</sub> =1V，I <sub>C</sub> =50mA
		40				V <sub>CE</sub> =1V，I <sub>C</sub> =500mA
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压			0.6	V	I <sub>C</sub> =500mA，I <sub>B</sub> =50mA
V <sub>BE(sat)</sub>	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I <sub>C</sub> =500mA，I <sub>B</sub> =50mA
V <sub>BE(on)</sub>	基极—发射极导通电压	0.6		0.73	V	V <sub>CE</sub> =1V，I <sub>C</sub> =10mA
BV <sub>CBO</sub>	集电极—基极击穿电压	40			V	I <sub>C</sub> =100μA，I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	20			V	I <sub>C</sub> =1mA，I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	5			V	I <sub>E</sub> =100μA，I <sub>C</sub> =0